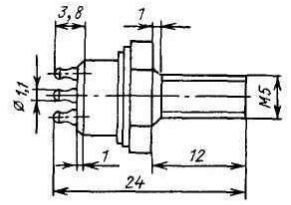
2Т606А, КТ606А, КТ606Б

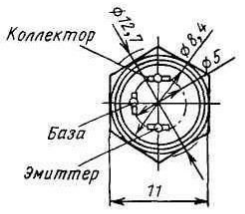
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* генераторные сверхвысокочастотные

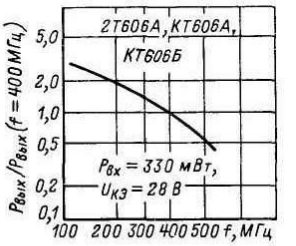
Предназначены для применения в схемах усилителей мощности, в том числе при амплитудной модуляции в умножителях частоты и автогенераторах на частотах выше 100 МГц при напряжении питания 28 В

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с изолированными от корпуса жесткими выводами с монтажным винтом Обозначение типа приводится на корпусе.

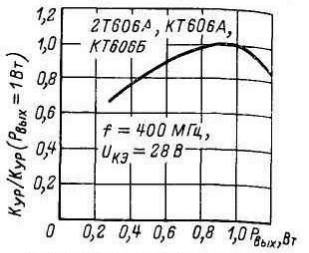
Масса транзистора не более 6 г.



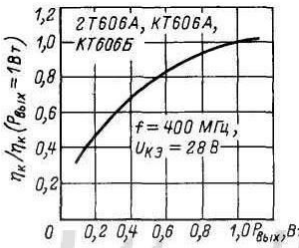




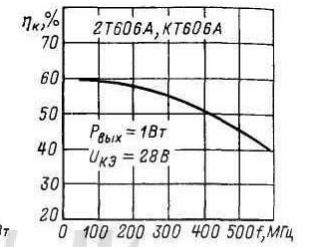
Зависимость относительной выходной мощности от частоты



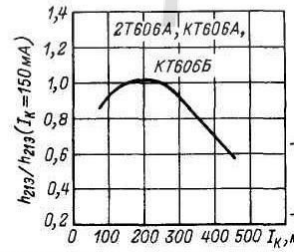
Зависимость относительного коэффициента усиления от выходной мощности



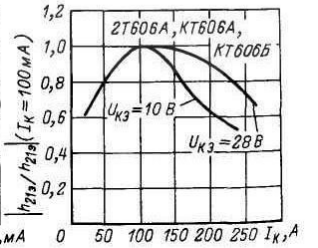
Зависимость относительного коэффициента полезного действия от выходной мощности



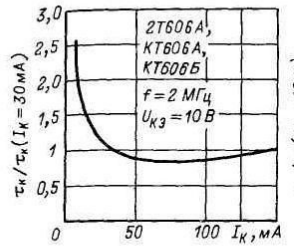
Зависимость коэффициента полезного действия от частоты



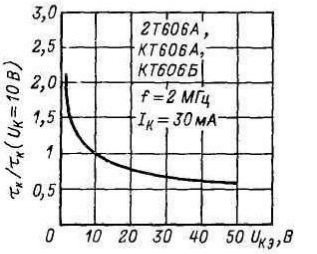
Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



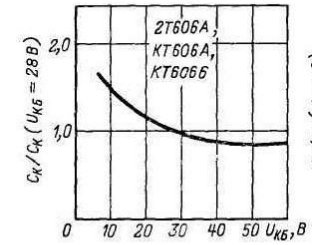
Зависимость модуля относительного коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость относительной постоянной времени цепи обратной связи от тока коллектора



Зависимость относительной постоянной времени цепи обратной связи от напряжения коллектор-эмиттер



Зависимость относительной емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база

Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{КЭ} = 28$ В, $f = 400$ МГц, не менее	
2Т606А, КТ606А	0,8 Вт
КТ606Б	0,6 Вт
Коэффициент усиления по мощности не менее	2,5
типовое значение	3*
Коэффициент полезного действия коллектора не менее	35 %
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер* при $I_К = 200$ мА, $I_Б = 40$ мА не более	1,0 В
Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100$ МГц, $U_{КЭ} = 10$ В, $I_К = 100$ мА не менее:	
2Т606А, КТ606А	3,5
КТ606Б	3
Критический ток коллектора при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 100$ МГц не менее	100 мА
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 5$ МГц, $I_Э = 30$ мА не более:	
2Т606А, КТ606А	10 нс
КТ606Б	12 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 28$ В, $f = 5$ МГц не более	10 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5$ МГц не более	27 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 65$ В, $R_{ЭБ} = 100$ Ом не более:	
при $T = 298$ К	
2Т606А	1 мА
КТ606А, КТ606Б	1,5 мА
при $T = 358$ К	
КТ606А, КТ606Б	3 мА
при $T = 398$ К 2Т606А	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В при $T = 298$ К не более:	
2Т606А	0,1 мА
КТ606А, КТ606Б	0,3 мА

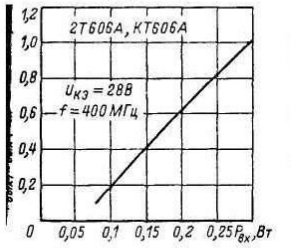
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leqslant 10$ Ом:	
2Т606А	65 В
КТ606А, КТ606Б	60 В
Пиковое напряжение коллектор-эмиттер при $f \geqslant 100$ МГц.	
2Т606А	5 В
КТ606А, КТ606Б	70 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	400 мА
Пиковый ток коллектора	800 мА
Постоянный ток базы	100 мА
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме:	
при $T_к = 313$ К	2,5 Вт
при $T_к = 398$ К 2Т606А	0,57 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	44 К/Вт
Температура перехода:	
2Т606А	423 К
КТ606А, КТ606Б	393 К
Температура окружающей среды:	
2Т606А	От 213 до $T_к = 398$ К
КТ606А, КТ606Б	От 233 до $T_к = 358$ К

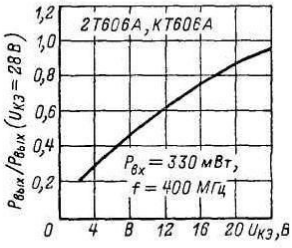
Примечание. При монтаже транзисторов допускается усилие, перпендикулярное оси вывода, не более 50 г, категорически запрещается изгиб выводов, а также их кручение вокруг оси.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм от корпуса транзистора.

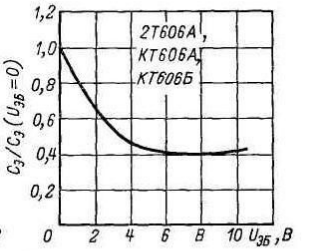
Использование транзистора без теплоотвода не рекомендуется. Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть менее 2,5 Неплоскостность контактной поверхности теплоотвода должна быть не более 0,03 мм.



Зависимость относительной выходной мощности от входной.



Зависимость относительной выходной мощности от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость относительной емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база

http://alltransistors.com